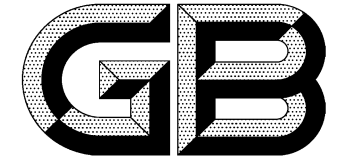


ICS 71.040.40
N 33



中华人民共和国国家标准

GB/T 20175—2006/ISO 14606:2000

GB/T 20175—2006/ISO 14606:2000

表面化学分析 溅射深度剖析 用层状膜系为参考物质的优化方法

Surface chemical analysis—Sputter depth profiling—
Optimization using layered system as reference materials

(ISO 14606:2000, IDT)

中华人民共和国
国家标准
表面化学分析 溅射深度剖析
用层状膜系为参考物质的优化方法
GB/T 20175—2006/ISO 14606:2000

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcs.com
电话:68523946 68517548

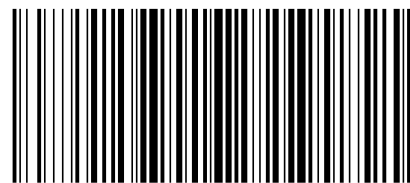
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 30 千字
2006年11月第一版 2006年11月第一次印刷

*
书号:155066·1-28262 定价 13.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 20175-2006

2006-03-27 发布

2006-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 符号和缩略语	2
4 溅射深度剖析的参数设定	2
5 溅射深度剖析时理想突变界面的深度分辨	4
6 参数设定优化的步骤	5
附录 A (资料性附录) 影响深度分辨的因素	7
附录 B (资料性附录) 典型单层膜系参考物质	9
附录 C (资料性附录) 典型多层膜系参考物质	10
附录 D (资料性附录) 多层膜系的使用	11
参考文献	12

- [37] SEAH M. P. and DENCH W. A. Quantitative Electron Spectroscopy of Surfaces: A Standard Data Base for Electron Inelastic Mean Free Paths in solids. Surface and Interface Analysis, 1, 1979, pp. 2-11.
- [38] TANUMA S. , POWELL C. J. and PENN D. R. Calculations of Electron Inelastic Mean Free Paths (IMFPs). Surface and Interface Analysis, 20, 1993, pp. 77-89.
- [39] VEISFELD N. and GELLER J. D. Ion Sputtering Yield Measurements for Submicrometer Thin Film. J. Vac. Sci. Technol. , A6, 1998, pp. 2077-2081.
- [40] SYKES D. E. , HALL D. D. , THURSTANS R. E. and WALLS J. M. Improved Sputter-Depth Profiles Using Two Ion Guns. Appl. Surface Science, 5, 1980, pp. 103-106.
- [41] FINE J. and NAVINSEK B. Characterization of NBS Standard Reference Material 2135 for sputter Depth Profile Analysis. J. Vac. Sci. Technol. , A3, 1985, pp. 1408-1412.
-

前 言

本标准等同采用 ISO 14606:2000《表面化学分析 溅射深度剖析 用层状膜系作为参考物质的优化方法》。

本标准附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 为资料性附录。

本标准由全国微束标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：清华大学电子工程系。

本标准主要起草人：查良镇、陈旭、王光普、黄雁华、黄天斌、刘林、葛欣、桂东。